افزایش پهنای باند آنتن تشدیدی عایقی با بهرهگیری از پهنای متغیر ساختار

پژمان رضائی^{۱،*}

چکیدہ	اطلاعات مقاله
در این مقاله، سـاختار آنـتن تشـدیدی عـایقی مسـتطیلی، تغذیـه شـده توسـط یـک خـط	
مایکرواستریپ بررسی و تکنیکهای بهبود رفتار آن مرور شده است. بدین منظور،	
نحوه عملکرد تشعشعی آنتن عایقی مطالعه و روشهای مختلف بهبود آن و به طور	واژگان کلیدی:
خـاص افـزایش پهنـای بانـد آن بررسـی شـده اسـت. سـپس سـاختار جدیـدی بـا هـدف	آنـــــتن تشــــدیدی عــــایقی
افـزایش پهنـای بانـد امپدانسـی آن پیشـنهاد شـده اسـت. در سـاختار معرفـی شـده، بـا	مستطیلی،
بهره گیـری از سـاختاری یکپارچـه ولـی چندبخشـی بـا ابعـاد مختلـف، بـا کـاهش پـارامتر	افزایش پهنای باند،
کیفیت آنستن، پهنسای بانسد آن افسزایش یافتسه اسست. بسرای سسادگی و کساهش تعسداد	پارامتر کیفیت،
پارامترهـای طراحـی، عـلاوه بـر حفـظ تقـارن سـاختار بـا ثابـت مانـدن ضـریب عـایقی و	ساختار غيريكنواخت.
ارتفاع قطعات، تغییـر ابعـاد ایـن قطعـات بـه عـرض آنهـا محـدود شـده اسـت. بـدین	
ترتیب، با بهرهگیری از ساختاری غیریکنواخت با پهنای متغیر، افزایش قابـل تـوجهی	
در پهنای باند آنتن ایجاد شده است. نتایج طراحی بیانگر تحقق پهنای امپدانسی	
بیش از ۵۲٪ با استفاده از ساختاری ۷ تکه میباشد.	

۱– مقدمه

تشدید کننده عایقی از مواد عایقی با تلفات کم ساخته شده است. فرکانس تشدید آن تابعی از ابعاد، شکل و ضریب نفوذپذیری الکتریکی قطعه عایق به کار رفته میباشد. به کارگیری تشدیدکننده های عایقی مزایای میعددی نظیر ابعاد کوچک، ارتفاع کم، سبکی و ارزانی را متعددی نظیر ابعاد کوچک، ارتفاع کم، سبکی و ارزانی را در پی دارد. قطعات عایقی به عنوان عنصر ذخیره کننده انرژی کاربرد وسیعی در فیلترها و نوسانسازهای مایکرویوی دارند [۱].

با توجه به انتشار مدهای تحریک شده در خارج عایق، بهرهگیری از آنها بهعنوان عنصر تشعشعی نیز مورد توجه قرار گرفت. از سال ۱۹۸۳ پس از ساخته شدن نخستین

آنتن عایقی استوانهای شکل، توسط لانگ و همکاران در دانشگاه هوستون، تحقیقات روی این آنتن توسعه یافته است [۲]. قطعات عایقی در کاربرد آنتنی از مزایایی همچون راندمان تشعشعی زیاد، ساختاری ساده و متراکم برخوردارند. این قطعات همچنین از لحاظ شکل هندسی و نحوه تغذیه متنوعند.

آنتنهای عایقی تشدیدی' (DRA) به سه شکل مستطیلی، استوانهای و نیمکره متداول میباشند. همچنین سه روش اصلی تغذیه این آنتن عبارتند از [۳]:

- با استفاده از خط مایکرواستریپ به صورت مستقیم
 - تزویج روزنهای
 - تغذیه با پروب

^{*} پست الكترونيك نويسنده مسئول: prezaei@semnan.ac.ir

۱. استادیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان

¹ Dielectric resonator Antenna

در این مقاله، آنتن عایقی مستطیلی شکل تحریک شده به صورت مستقیم توسط یک خط مایکرواستریپ مورد توجه قرار گرفته است.

۲-بهینهسازی آنتن عایقی تشدیدی

در دو دهه اخیر، روشهای مختلفی برای بهینهسازی ساختار آنتن عایقی تشدیدی، به منظور بهبود عملکرد تشعشعی آن ارائه شده است. مهمترین اهداف این روشها را میتوان به افزایش پهنای باند یا چندباندی کردن آن، افزایش میزان تزویج و کارایی آنتن، کوچک سازی ابعاد ساختار، افزایش بهره، تنظیم پرتو و پلاریزاسیون تشعشعی آنتن تفکیک نمود. در برخی موارد با بهره گیری از این روشها بیش از یک هدف نیز به طور همزمان محقق شده است [۳–۱۰].

افزایش میزان تزویج از خط تغذیه مایکرواستریپ به آنتن با بهرهگیری از ساختارهای چندلایه با افزودن زیرلایههایی با ارتفاع و ضریب عایقی مناسب محقق شده است [۱۱].



شکل ۱- آنتن DRA مستطیلی چندلایه جهت افزایش تزویج

در طراحی آنتن عایقی چندبخشی، توصیه می شود که ضخامت لایه اضافه شده می بایست به گونه ای انتخاب شود که نسبت hL/(hL+hU) بین ۱/۱ تا ۰/۳ باشد [۱۱]. بدین ترتیب این لایه گذردهی مؤثر (eff3) را تغییر می دهد. در مراجع این مقدار با استفاده از مدل متوسط وزین شده به دو فرم زیر محاسبه می شود [۱۱–۱۳]:

$$\varepsilon_{eff} = \frac{h_U + h_L + h_S}{h_U / \varepsilon_U + h_L / \varepsilon_L + h_S / \varepsilon_S}$$
(1)

و

$$\varepsilon_{eff} = \frac{\varepsilon_U h_U + \varepsilon_L h_L + \varepsilon_S h_S}{h_U + h_I + h_S}$$
(7)

و فرکانس تشدید آنتن عایقی دو بخشی به صورت زیر محاسبه می شود:

$$f_r = \frac{h_U f_u + h_L f_L + h_S f_S}{h_U + h_L + h_S} \tag{(7)}$$

که در آن اندیسهای ضخامت و فرکانس S، L و U به ترتیب مربوط به زیرلایه، لایه باریک پایینی اضافهشده و لایه بالایی (قطعه اصلی آنتن) میباشد. کوچکسازی ابعاد ساختار آنتن DR نیز بر مبنای اصل تصویر با استفاده از فرم عایق نصف شده و نیز قطاعی با افزودن صفحهای فلزی بعنوان دیوار الکتریکی و نیز بهره گیری از پچهای پارازیتی^۱ بهدست میآید [۱۸–۱۸].



مرور تحقیقات صورت گرفته نشان میدهد که افزایش پهنای باند آنتن تا دستیابی به پهنای باندی وسیع تا ۱۲۰٪، سهم بالایی را به خود اختصاص داده است [۴-۶]. در ادامه، برخی از این روشها به اختصار مرور شده است.

۲-۱- روشهای افزایش پهنای باند

یکی از روشهای افزایش پهنای باند ساختار مستطیلی استفاده از ساختاری شکافدار^۲ به منظور کاهش فاکتور کیفیت^۳ (با کاهش انرژی ذخیره شده) است. در این روش، مطابق شکل ۳، حفرهای در داخل عایق ایجاد میشود که افزایش پهنای باند ساختار را در پی خواهد داشت [۱۹].

¹ Parasitic Patch

² Notched

³ Quality Factor



از تکنیک پلهای کردن عایق آنتن نیز به عنوان روشی برای افزایش پهنای باند آن استفاده شده است. برای نمونه با بهره گیری از ساختار سه پلهای و تنظیم فرورفتگی پلهها به فرم شکل ۴ پهنای باندی بیش از ٪۱۰ برای امپدانس و پرتو تشعشعی به دست آمده است [۲۰].



به طور معمول، در ساختارهای مستطیلی مدهای بیشتری در مقایسه با استوانهای تحریک می شود [۲۱]. البته در ساختار استوانهای نیز تحریک مد مرتبه بالاتر در مجاورت مد اصلی با تنظیم نسبت ارتفاع به شعاع آن امکان پذیر می باشد. بیشترین پهنای باند به طور تجربی برای نسبت ۰/۳۲۹

همچنین ساختارهایی شامل تشعشع کنندههای اضافی با پرتو تشعشعی مشابه با ایجاد خاصیت تشدیدی در چندین باند فرکانسی مجزا، پهنای باند وسیعی را ایجاد میکنند [۲۳-۲۳]. به کارگیری ساختار آنتن با شکلهای خاص نیز در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است [۲۷-۲۲].

۳-ساختار پیشنهادی

ایده روشهای جدید به طور معمول از تئوریهای موجود در زمینه افزایش پهنای باند در ساختارهای مشابهی نظیر آنتنهای پچ مایکرواستریپ ناشی میشود. همچنین با ایجاد تغییراتی در روشهای قبل، میتوان عملکرد آنتن را ارتقاء بیشتری بخشید. برای مثال، با بهرهگیری از دو ساختار عایقی نیمه در طرفین دیوار الکتریکی میتوان پهنای باند آن را افزایش داد [۲۹–۳۱]. میتوان برای دستیابی به حداکثر پهنای باند امپدانسی فرم خط تغذیه را به منظور بهبود تزویج اصلاح کرد [۲۳] یا نسبت بین ابعاد عایق مستطیلی را به شکل مناسب تنظیم نمود [۳۳]. همچنین با بهکارگیری زیرلایهای مغناطیسی به جای عایقی یا توأم با آن، پهنای باند آن را به صورت قابل توجهی افزایش داد [۳۳–۳۵].

در این تحقیق، ساختاری متشکل از چندین قطعه عایق با ابعاد متفاوت به جای عایق یکپارچه معمول ارائه شده است. در این ساختار هر بخش عایقی خود دارای سه متغیر طول، عرض و ارتفاع میباشد. به لحاظ دشواری کنترل تغییرات پارامترهای متعدد و نیز حفظ تقارن شکل پرتو تشعشعی آنتن، طراحی روی ساختاری متقارن تمرکز یافته است. بدین منظور، ساختارهایی با تعداد قطعات عایقی فرد (۳، ۵، ۷ و ...) بررسی شده است. نمایی کلی از ساختار با پهنای متغیر پیشنهادی در شکل ۵ نشان داده شده است.



ایده به کار رفته در این طرح مشابه طرح عایقی پلهای میباشد. البته در ساختار جدید تغییرات عرض قطعه

جایگزین تغییرات ارتفاع شده است. به عبارتی در کل ساختار ارتفاع عناصر عایقی یکسان میباشد. همچنین در روش پیشنهادی تقارن ساختار مورد تأکید قرار گرفته است. بدین ترتیب در یک ساختار متقارن N تکهای تعداد پارامترهای طراحی از 3N به 2+N متغیر کاهش یافته است. این کاهش برای N های بزرگ قابل ملاحظه میباشد. برای مثال، در ساختار ۷ تکه تعداد متغیرهای طراحی از ۲۱ به ۹ کاهش یافته است.

برای شبیهسازی ساختار عایقی آنتن و صفحه زمین آن از نرمافزار Ansoft-HFSS بهره گرفته شده است. اساس عملکرد این نرمافزار روش عددی تمام موج اجزاء محدود⁽ (FEM) میباشد [۳۶].

۳-۱- طرح اولیه آنتن عایقی مستطیلی

در گام نخست یک طراحی مناسب برای ساختار عایقی تشدیدی مستطیلی صورت گرفته است. به منظور دستیابی به پهنای باند وسیعتر ساختاری تیغهای (با عرض کم) مورد توجه قرار گرفته است. علت آنست که انتخاب نسبت ابعاد مناسب، کاهش فاکتور کیفیت و در نتیجه افزایش پهنای باند امپدانسی را در پی دارد [۳۱].

ابعاد اولیه آنتن عایقی تشدیدی مستطیلی با استفاده از معادلات توسعه یافته برای مدل موجبر عایقی برای یک تشدید کننده مستطیلی به فرم زیر تعیین می شود [۳۷].

$$f_{0} = \frac{c}{2\pi\sqrt{\varepsilon_{r}}}\sqrt{k_{x}^{2} + k_{y}^{2} + k_{z}^{2}}$$
 (*)

که در آن:

$$k_x = \frac{\pi}{a} ,$$

$$k_y = \frac{\pi}{b} ,$$
(Δ)

 $k_z \tan(k_z d/2) = \sqrt{(\varepsilon_r - 1)k_0^2 - k_z^2}$ که k_z , k_y , k_x عدد موج در داخل عایق تشدیدی به k_z , k_y , k_x ترتیب در امتداد مسیرهای X ، Y و Z است. سپس ابعاد

ساختار بطور تجربی برای یک نسبت ابعاد بهینه بدست میآید. ابعاد قطعه عایقی با نسبت ابعاد مناسب بدست آمده به روش سعی و خطا، شامل طول و عرض (a, a) به ترتیب ۲۰ و ۳ میلیمتر و ارتفاع قطعه نیز ۱۲ میلیمتر میباشد. ابعاد قطعه به ترتیب معادل ۲۰/۳۰، ۲۰/۰ و ۰/۲ طول موج در فرکانس مرکزی ۵ گیگاهرتز میباشد. همچنین با تنظیم محل استقرار عایق روی خط تغذیه، تطبیق امپدانسی مناسبی محقق میشود. قطعه عایقی به فرم شکل ۶ روی خط تغذیه مایکرواستریپ ۵۰ اهمی قرار گرفته است.

منحنی بخشهای حقیقی و موهومی امپدانس ورودی آنتن عایقی طراحی شده روی خط تغذیه مایکرواستریپ در بازه فرکانسی ۴ تا ۶ گیگاهرتز در شکل ۷ نشان داده شده است.



شکل ۶- نحوه استقرار آنتن عایقی روی خط تغذیه مایکرواستریپ



منحنی پاسخ فرکانسی افت برگشتی آنتن عایقی نیز در بازه ۴ تا ۶ گیگاهرتز در شکل ۸ نشان داده شده است.

¹ Finite Element Method

هدف این طراحی، ترکیب دو باند فرکانسی مجاور برای کاربردی پهنباند با کمترین همپوشانی است. مطابق شکل، ساختار تیغهای طراحی شده دارای دو فرکانس تشدید در فرکانسهای ۴/۸۳ و ۵/۵۴ گیگاهرتز است. همچنین دارای باند تطبیق یافته امپدانسی یکپارچهای در بازه ۴/۵۵ تا ۵/۷۳ گیگاهرتز میباشد که بیانگر دستیابی به پهنای باند فرکانسی ٪۲۱/۳۲ در این مرحله است.



۲-۳- طرح بهبود يافته غيريكنواخت

پس از دستیابی به طرح اولیه مناسب، با تفکیک آن به N بخش مجزا و تغییر عرض آنها تحقق پهنای باندی وسیعتر دنبال شده است. ارتفاع قطعات عایقی نیز ثابت در نظر گرفته شده است. پارامترهای ساختار یک آنتن عایقی Y بخشی متقارنی در شکل ۹ معرفی شده است.



نتایج به دست آمده بیانگر آنست که در یک پروفایل عرضی غیریکنواخت، قسمت مرکزی عریض و انتهای باریک نتایج مناسبی دارد. نمونهای از ابعاد ساختار طراحی شده ۷ تکه بهبود یافته در جدول ۱ ارائه شده است.

جدول ۱- ابعاد ساختار آنتن عايق ۲ تکهای بهبود يافته

عرض	طول	المان	
d (mm)	a (mm)	#	
۵	۴	١	
٧	۱/۵	۲	
١/٢	۴/۵	٣	
۱/۶	٢	۴	

منحنی بخشهای حقیقی و موهومی امپدانس ورودی آنتن عایقی طراحی شده بهبود یافته روی خط تغذیه مایکرواستریپ در بازه فرکانسی ۴ تا ۹ گیگاهرتز در شکل ۱۰ نشان داده شده است.



مطابق شکل ۹ تغییرات هر دو بخش حقیقی و موهومی امپدانس در بازهای در حدود ۴/۹ تا ۸/۷ گیگاهرتز به خوبی حول مقدار ۰ز+۵۰ کنترل شده است. منحنی افت برگشتی آنتن عایقی بهبود یافته در بازه فرکانسی ۴ تا ۹ گیگاهرتز در شکل ۱۱ نشان داده شده است.



ساختار عایقی مستطیلی طراحی شده در این مرحله دارای سه فرکانس تشدید در فرکانسهای ۵/۳۵، ۷/۰۱ و

۷/۷۶ گیگاهرتز است. همچنین دارای باند امپدانسی تطبیق یافته در باندهای ۴/۹۷ تا ۸/۵۵ گیگاهرتز میباشد که بیانگر دستیابی به پهنای باند امپدانسی معادل ۵۲/۹۶ درصد میباشد.

٨۴

از نظر اندازه آنتن نیز علی رغم ثابت ماندن طول مجموع قطعات (در ۲۰ میلی متر)، با وجود تغییرات عرض قطعات، در مجموع حجم آن از ۷۲۰ به ۶۹۸/۴ میلی متر مکعب کاهش یافته است.

در ادامه کار تأثیر تعداد عناصر عایقی و به عبارتی مزیت بهره گیری از پارامترهای بیشتر در طراحی آنتن مورد توجه واقع شده است. بدین منظور تعداد بخشهای عایقی از ۲ بخش به ۳ بخش کاهش یافته است. با توجه به نزدیکی پهنای المانهای ۱ و ۲ و نیز المانهای ۳ و ۴ به هم، مطابق شکل ۱۲ تعداد عناصر عایقی از ۲ به ۳ المان کاهش یافته است.



شکل ۱۲ - ساختار آنتن عایق ۳ تکهای

در آنتن عایقی ۳ تکهای جدید، با بهرهگیری از سادهترین فرمول ممکن، طول المان از ترکیب دو طول مجاور ترکیب شده و نیز عرض تکههای عایقی ساختار نیز با متوسط گیری از دو عرض ترکیب شده به دست آمده است. ارتفاع ساختار نیز همچنان ثابت در نظر گرفته شده است. ابعاد طول و عرض به دست آمده ساختار بهبود یافته در جدول ۲ ارائه شده است.

لمول ۲ ابعاد سامتار الس عايق ۲ لکای	تكەاي	عايق ۳	نار آنتن	عاد ساخة	دول ۲- اب	جا
-------------------------------------	-------	--------	----------	----------	-----------	----

عرض	طول	المان
d (mm)	a (mm)	#
۶	٧	۱و۲
١/۴	\mathcal{P}/Δ_{0}	٣و۴

منحنی افت برگشتی آنتن عایقی ۳ تکه جدید نیز در بازه فرکانسی ۴ تا ۹ گیگاهرتز در شکل ۱۳ نشان داده شده است. به علت تشابه بالای منحنیهای امپدانس ورودی آنتن با ساختار قبل و عدم درک تمایز آنها از تکرار آنها اجتناب شده است.



همانطور که از مقایسه منحنی شکلهای ۱۰ و ۱۲ کاملاً مشهود است، عدم تطبیق امپدانسی آنتن ۳ تکهای افزایش یافته بهطوریکه علاوه بر بالا آمدن سطح منحنی در کل باند، باند فرکانسی یکپارچه را نیز از دست دادهایم. بدین ترتیب با تبدیل ساختار ۲ تکه به ساختاری ۳ تکهای و بهعبارتی کاهش درجه آزادی طراحی آنتن، نتایج تطبیق امپدانسی آن به طور ملموسی تنزل یافته است.

در ادامه، تأثیر تغییر ساختار ایجاد شده علاوه بر امپدانس ورودی، بر شکل پرتو تشعشعی آنتن نیز بررسی شده است. پاسخ فرکانسی بهره تشعشعی ساختار ۲ تکهای بهبود یافته در بازه فرکانسی ۴ تا ۹ گیگاهرتز، در شکل ۱۴ نشان داده شده است.



مطابق شکل فوق، بیشترین نوسان بهره تشعشعی آنتن بین فرکانسهای ۵/۵ تا ۸/۴ گیگاهرتز و در حدود ۱۰ دسیبل میباشد. مقایسه نتایج بیانگر آن است که با به-کارگیری تکنیک معرفی شده پهنای باند امپدانسی بیشتری در مقایسه با روش ارتفاع متغیر بهدست آمده است [۲۰]. البته استفاده از این پهنای باند به صورت منفصل میباشد و به عبارتی مستلزم بهکارگیری آنتن در مدهای مختلف و با شکل پرتوهای تشعشعی متفاوت میباشد [۳۸]. با ترکیب این دو ایده و تغییر توأم ارتفاع و عرض قطعات عایقی، نتایج بهتری نیز دستیافتنی به نظر میرسد.

۴-بحث

معمولاً برای بهبود تبادل حرارتی در کاربردهایی نظیر پردازنده رایانه از فرمهای رادیاتوری شکل استفاده میشود. علت این امر افزایش سطح تماس مفید برای تبادل حرارتی با محیط است. در ساختار پیشنهادی نیز این مسئله مورد تأکید قرار گرفته است. پارامتر کیفیت آنتن تابعی از نسبت انرژی ذخیره شده در حجم به توان تشعشعی از سطح است. بدین ترتیب کیفیت تابعی از نسبت حجم قطعه عایقی به سطوح جانبی تشعشع کننده است. رابطه بین کیفیت آنتن و ساختار هندسی عایق در فرکانس ∞ به فرم رابطه ۶ است [۳۸].

$$Q = 2\omega_0 \frac{\text{Stored Energy}}{\text{Radiated Power}}$$

$$\propto 2\omega_0 \varepsilon_r^{\ p} \left(\frac{\text{Volume}}{\text{Surface}}\right)^{\text{s}} \text{ with } p > s \ge 1$$
(7)

که همواره یکی از وجوه قطعه عایقی روی خط تغذیه میکرواستریپ قرار گرفته و تشعشع از سایر وجوه (۵ وجه) آن صورت میگیرد. نسبت حجم به سطح تشعشعی برای سه ساختار مختلف بررسی شده، شامل عایق مکعبی، ساختار طراحی شده تیغهای و نیز ساختار ۷ تکه طراحی شده در جدول ۳ مقایسه شده است.

جدول ۳- مقایسه نسبت حجم به سطح تشعشعی در ۳ طرح

٨۵

فطعه عايفي			
نسبت	سطوح تشعشع	حجم قطعه	طرح
V/S	mm ²	mm ³	آنتن
١/٧٩٢	4.1/88	۷۲۰	مكعب
۱/۱۷۶	817	۷۲۰	تيغەاي
٠/٨٩١	۲۷۳/۴	۶۹۸/۴	۷ تکهای

مطابق رابطه ۶، در ساختار ۷ تکهای با کاهش نسبت حجم به سطح تشعشعی، پارامتر کیفیت ساختار کاهش یافته و در نتیجه پهنای باند ساختار افزایش یابد. بدیهی است که با افزایش تعداد N و افزایش تغییرات سطوح آنتن نسبت حجم به سطح کاهش یافته که کاهش پارامتر کیفیت آنتن و افزایش پهنای باند را در پی خواهد داشت. البته با افزایش پارامترها، طراحی آنتن مستلزم به کارگیری یکی از الگوریتمهای بهینهسازی میباشد.

۵-نتیجهگیری

در این مقاله، افزایش پهنای باند امپدانسی یک آنتن عایقی مستطیلی تغذیه شده توسط خط مایکرواستریپ مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور ساختار جدیدی برای افزایش پهنای باند آنتن، با کاهش پارامتر کیفیت آن پیشنهاد شده است. در ساختار معرفی شده با بهره گیری از ساختاری یکپارچه و متقارن و چندین بخشی با طول و عرض مختلف، پهنای باند افزایش یافته است. با افزایش تعداد بخشهای عایقی، پهنای باند آن افزایش بیشتری مییابد که البته دشواری طراحی ساختار و نیز برش طراحی بهینه برای ساختار، کاره مورت گرفته است. با بهره گیری از این ساختار، علاوه بر کاهش حجم ساختار و اخذ شکل پرتوی مناسب، پهنای باند امپدانسی از ۲۱/۳٪ به ۵۲/۹۶٪ افزایش یافته است.

تقدیر و تشکر

این تحقیق با حمایت دانشگاه سمنان صورت گرفته است. نویسنده مقاله کمال تشکر را از اصلاحات ارزنده داوران، ابراز میدارد.

¹ Heat Sink

مراجع

- [1] Kajfez, D., Guillon, P. (1986), "Dielectric Resonators". Artech House.
- [2] Long, S.A., McAllister, M.W., Shen, L.C. (1983), "The resonant cylindrical dielectric cavity antenna". IEEE Trans. on Antennas and Propagation, Vol. 31, pp. 406-412.
- [3] Petosa, A., Ittipiboon, A., Antar, Y.M.M., Roscoe, D. (1998), "Recent advances in dielectric resonator antenna technology". IEEE Antennas and Propagation Magazine, Vol. 40, pp. 35-48.
- [4] Luk, K.M., Leung, K.W. (2003), "Dielectric Resonator Antennas". Research Studies Press Ltd.
- [5] Petosa, A. (2007), "Dielectric Resonator Antenna Handbook". Artech House Publishers.
- [6] Petosa, A., Ittipiboon, A. (2010), "Dielectric resonator antennas: A historical review and the current state of the art". IEEE Antennas and Propagation Magazine, Vol. 52, pp. 91-116.
- [7] Batra, D., Sharma, S., Kohli, A.K. (2012), "Dual-band dielectric resonator antenna for C and X band application". Intl. J. Antennas and Propagation, No. 914201, pp. 1-7.
- [8] Petosa, A., Thirakoune, S. (2011), "Rectangular dielectric resonator antennas with enhanced gain". IEEE Trans. on Antennas and Propagation, Vol. 59, pp. 1385-1389.
- [9] Gao, Y., Feng, Z., Zhang, L. (2012), "Compact asymmetrical T-shaped dielectric resonator antenna for broadband applications". IEEE Trans. on Antennas and Propagation, Vol. 60, pp. 1611-1615.
- [10] Ge, Y., Esselle, K.P., Bird, T.S. (2011), "Compact dielectric resonator antennas with ultrawide 60%-110% bandwidth". IEEE Trans. on Antennas and Propagation, Vol. 59, No. 9, pp. 3445-3448.
- [11] Petosa, A., Simons, N., Siushansian, R., Ittipiboon, A., Cuhaci, M. (2000), "Design and analysis of multisegment dielectric resonator antennas". IEEE Trans. on Antennas and Propagation, Vol. 48, No. 5, pp. 738-742.
- [12] Rashidian, A., Forooraghi, K., Tayfeh-Aligodarz, M. (2005), "Investigations on two-segment dielectric resonator antennas". Microwave and Optical Technology Letters, Vol. 45, No. 6, pp. 533-537.
- [13] Rashidian, A., Klymyshyn, D.M. (2009), "On the two segmented and high aspect ratio rectangular dielectric resonator antennas for bandwidth enhancement and miniaturization". IEEE Trans. on Antennas and Propagation, Vol. 57, No. 9, pp. 2775-2780.
- [14] Tam, M.T.K., Murch, R.D. (1997), "Half volume dielectric resonator antenna designs". Electronics Letters, Vol. 33, No. 23, pp. 1914-1916.
- [15] O'Keefe, S.G., Kingsley, S.P., Saario, S. (2002), "FDTD simulation of radiation characteristics of halfvolume HEM and TE-mode dielectric resonator antennas". IEEE Trans. on Antennas and Propagation, Vol. 50, No. 2, pp. 175-179.
- [16] Tam, M.T.K., Murch, R.D. (1999), "Compact circular sector and annular sector dielectric resonator antennas". IEEE Trans. Antennas and Propagation, Vol. 47, No. 5, pp. 837-842.
- [17] Guha, D., Gupta, B., Kumar, C., Antar, Y.M.M. (2012), "Segmented hemispherical DRA: New geometry characterized and investigated in multi-element composite forms for wideband antenna applications". IEEE Trans. on Antennas and Propagation, Vol. 60, No. 3, pp. 1605-1610.
- [18] Hui, K.Y., Luk, K.M. (2005), "A miniature dielectric resonator loaded patch antenna". IEEE Trans. on Antennas and Propagation, Vol. 53, No. 6, pp. 2118-2122.
- [19] Ittipiboon, A., Petosa, A., Roscoe, D., Cuhaci, M. (1996), "An investigation of a novel broadband dielectric resonator antenna". IEEE Antennas and Propagation Society Intl. Symp., pp. 2038-2041, USA.
- [20] Pliakostathis, K., Mirshekar-Syahkal, D. (2004), "Stepped dielectric resonator antennas for wideband applications". IEEE Antennas and Propagation Society Intl. Symp., pp. 1367-1370, USA.
- [21] Li, B., Leung, K.W. (2005), Strip-fed rectangular dielectric resonator antennas with/without a parasitic patch". IEEE Trans. on Antennas and Propagation, Vol. 53, No. 7, pp. 2200-2207.

رضائى

- [23] Buerkle, A., Sarabandi, K., Mosallaei, H. (2005), "Compact slot and dielectric resonator antenna with dualresonance, broadband characteristics". IEEE Trans. on Antennas and Propagation, Vol. 53, No. 3, pp.1020-1027.
- [24] Denidni, T.A., Rao, Q. (2004), "Hybrid dielectric resonator antennas with radiating slot for dual-frequency operation". IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, Vol. 3, No. 1, pp. 321-323.
- [25] Lapierre, M., Antar, Y.M.M., Ittipiboon, A., Petosa, A. (2005), "Ultra wideband monopole/dielectric resonator antenna". IEEE Microwave and Wireless Components Letters, Vol. 15, No. 1, pp. 7-9.
- [26] Kishk, A. (2005), "Experimental study of broadband embedded dielectric resonator antennas excited by a narrow slot". IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, Vol. 4, pp. 79-81.
- [27] Denidni, T.A., Zibin W., Niroo-Jazi, M. (2010), "Z-shaped dielectric resonator antenna for ultra wideband applications". IEEE Trans. on Antennas and Propagation, Vol. 58, No. 12, pp. 4059-4062.
- [28] Thamae, L.Z., Zhipeng, W. (2010), "Broadband bowtie dielectric resonator antenna". IEEE Trans. on Antennas and Propagation, Vol. 58, No. 11, pp. 3707-3710.
- [29] Rezaei, P., Hakkak, M., Forooraghi, K. (2006), "Dielectric resonator antenna for wireless LAN applications". IEEE Intl. Symp. on Antennas and Propagation, pp. 1005-1008.
- [30] Rezaei, P., Hakkak, M., Forooraghi, K. (2007), "Wide-band rectangular dielectric resonator antenna". 15th Iranian Conf. on Elec. Eng., pp. 17-22.
- [31] Rezaei, P., Hakkak, M., Forooraghi, K. (2006), "Design of wide-band dielectric resonator antenna with a two-segment structure". Progress in Electromag. Res., Vol. 66, pp. 111-124.
- [32] Rezaei, P., Hakkak, M., Forooraghi, K. (2006), "Multi-band rectangular dielectric resonator antenna with Crank-shape feed-line". 7th Intl. Symp. on Antennas and Propagation and EM Theory, Vol. 1, pp. 195-198.
- [33] Rezaei, P., Hakkak, M., Forooraghi, K. (2007), "Effect of magnetic layer on the microstrip-excited rectangular dielectric resonator antennas bandwidth". J. Electromag. Waves and Appl., Vol. 21, No. 7, pp. 915-927.
- [34] Rezaei, P., Hakkak, M., Forooraghi, K. (2007), "Influence of magnetic layer on the microstrip-excited rectangular DRA bandwidth". IEEE Intl. Symp. on Antennas and Propagation, pp. 4893-4896.
- [35] Rezaei, P., Hakkak, M., Forooraghi, K. (2007), "Gap compensation of magnetic layer on the microstripexcited rectangular DRA". IEEE Intl. Symp. on Antennas and Propagation, pp. 3856-3859.
- [36] HFSS: High Frequency Structure Simulator Based on the Finite Element Method, (2004). Ansoft Corporation, USA.
- [37] Mongia, R.K., Ittipiboon, A. (1997), "Theoretical and experimental investigations on rectangular dielectric resonator antennas". IEEE Trans. on Antennas and Propagation, Vol. 45, No. 9, pp. 1348-1356.
- [38] Bit-Babik, G., Di-Nallo, C., Faraone, A. (2004), "Multimode dielectric resonator antenna of very high permittivity". IEEE Intl. Symp. on Antennas and Propagation, Vol. 2, pp. 1383-1386.

BANDWIDTH BROADENING OF DIELECTRIC RESONATOR ANTENNA BY NON UNIFORM WIDTH

P. Rezaei^{1,*}

1. Semnan University, Electrical Engineering and Computer Faculty

*Corresponding Author: prezaei@semnan.ac.ir

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords: Rectangular Dielectric Resonator Antenna, Broadening Bandwidth, Quality Factor, Non-Uniform Structure.

In this paper a rectangular dielectric resonator antenna (DRA) fed by a microstrip line is studied. Therefore, at first radiation performance of DRA is studied, and the improvement techniques are reviewed. Then propose a novel configuration for broadening of the impedance bandwidth. In the proposed arrangement, by using multi-segment structure with different dimensions, increase the antenna impedance bandwidth. However for decreasing the design parameters, variations limited to the segments width. So, with the non-uniform configuration by variable width, it is possible to create remarkable increase in frequency bandwidth. Utilizing the symmetrical seven-segment DRA and skillfully varying its aspect ratio, an appropriate structure is obtained that illustrates more than 52% impedance bandwidth for S_{11} >10.